京都大学化学研究所 D2 岡 研吾

課題番号:2007B1674

利用ビームライン:BL02B2

課題名:MEM解析による PbVO3 における巨大強誘電歪みの起源解明

目的及び研究背景

近年,磁性と強誘電性を併せ持つ磁性強誘電体が次世代メモリー材料,セン サー材料への応用の期待から注目を集めている. PbVO₃ もその磁性強誘電体の 一つである. PbVO₃ は高圧合成によって見つかった新しいペロブスカイト化合 物であり[1,2],この物質は代表的な強誘電体である PbTiO₃ と同じ結晶構造を持 ち,原子座標からは,それを超える 101μ C/cm2 もの分極が期待できる(Fig.1a inset).また,V⁴⁺のイオンを持つことから,その d^1 電子による磁性も期待できる. しかしながら,良質な試料の合成が難しく,その本質的な磁性には謎の部分が 多かった.

我々はこの PbVO₃ の単結晶試料を高圧水熱条件を用いて,BL14B1 で得られ た高圧X線回折パターンから合成条件を最適化することにより,単結晶を成長 させることに成功した.得られた結晶試料を用いて,磁化率の測定を行ったと ころ,この PbVO₃の磁性が 200K 付近に低次元磁性体に特有のブロードな極大 を持つ低次元的なものであることを見出した[3].これは三次元的なペロブスカ イト構造からは予想できない物性であった.また,その高温展開法を用いた磁 化率の解析により,その磁性が単純な二次元ハイゼンベルグ正方格子ではなく, J_1-J_2 モデルで説明できるフラストレートした磁性であることを見出した(Fig.1).

この低次元磁性の原因については,磁性を担う V^{4+} イオンの d^1 電子配置による ものと考えられる. BL02B2 の粉末回折データで決定した構造パラメータに基づ いて行われたバンド計算では, V^{4+} イオンが酸素にピラミッド型に配位されるこ とで 3d 軌道の縮退が解け, d_{xy} 軌道のエネルギーが下がる, という結果が示さ れている[4]. すなわち, d^1 電子配置の V^{4+} を持つ PbVO₃では, d_{xy} 軌道のみが電 子で占有され, その軌道秩序のために低次元磁性を示すと考えられる. つまり, この低次元磁性の観測は PbVO₃における d 電子の軌道秩序の間接的な証明であ ると言える.

そして、この軌道秩序を用いて PbVO₃の巨大な正方晶歪みの起源も説明できる. 対称中心を持つヤーンテラー歪みにおいて軌道縮退が解ける場合、 t_{2g} 軌道 は d_{xy} と縮退した d_{yx}, d_{zx} の二つに分かれる(Fig 2a) . 縮退した d_{yx}, d_{zx} の二つの軌 道のほうがエネルギーが低いため、このとき d^1 電子はこの縮退した軌道を占有 すると考えられる. 対して、Pb²⁺イオンの持つ 6s² 孤立電子対によってもたらさ れると考えられる対称中心を持たない VO₅のピラミッド型の配位においては、 d

軌道の軌縮退が解けて、*d*_{xy}軌道のエネルギーが5つの*d*軌道の中で最も低くなる(Fig. 2b). 逆に言えば、*d*¹電子を持つ V⁴⁺ではピラミッド型の配位を取り軌道縮退を解くことにより系のエネルギーを下げることが可能であるため、よりこのピラミッド型の配位が安定となり、その結果として巨大な正方晶歪みを安定化すると考えられる.

また、立方晶の PbVO₃を想定したとき、正八面体の配位において 3 つの t_{2g} 軌 道は縮退すると考えられる(Fig.2c).このとき d^1 電子は縮退した t_{2g} 軌道を占有し、 同じ立方晶のペロブスカイトである SrVO₃ と同様に金属的な導電性を示すと予 測できる.実際、室温での高圧粉末X線回折実験(BL14B1)において圧力 3GPa における正方晶から立方晶への構造相転移が観測されており、またそれに伴う 金属絶縁体転移も見られている[1].この実験事実は V⁴⁺の持つ d^1 電子が巨大な 正方晶歪みに寄与しているという説を支持するものである.

しかし、これまでの実験結果において一つの大きな課題があった. それは、 これらの実験結果は全て d^1 電子の軌道秩序の存在を間接的に証明するものであ り、直接的に軌道秩序を観察したわけではないということである. そこで我々 は電子密度を直接的に観測できる粉末X線回折パターンを用いた MEM 解析に 注目し、直接的に d^1 電子の軌道秩序を可視化してみせることを試みた.





(b)高温展開法でフィッティング (inset:ab 面における磁気的相互作用)



Fig.2 *d* 軌道のエネルギー準位. (a)ヤーンテラー歪み, (b)ピラミッド型配位, (c)正八面体配位

実験·解析手法

粉末X線回折データを用いて MEM 解析を行うには,強い強度と高い解像度が 不可欠である.そのためには大型デバイシェラーカメラを用い,輝度の高い放 射光を用いた BL02B2 での粉末X線回折実験が非常に望ましい.

本実験では,育成に成功した結晶試料を粉砕することで良質の粉末試料を用意,MEM 解析によって, *d*_{xy} 軌道のみが電子で占有された,一種の軌道秩序を可視化,確認することを目的として行った.

実験結果及び考察

波長 0.42 Åの X 線を用いて, 強い強度と高い解像度を持つ X 線回折パターン を温度 90 K で取ることに成功した.得られたパターンをリートベルト解析する ことにより, *R*_{WP} = 3.81 %, *R*_I = 0.96%まで結晶構造因子を最適化した(Fig.3).そ して,リートベルト解析を元に MEM 解析を行い,電子密度の可視化を行った. その結果,電子密度に *c* 軸に垂直な鏡面反射のようなものが見られ,本来原

子のないはずの位置にも電子密度が現れてしまった(Fig. 4). 単結晶X線回折実験における振動写真において、スポットがぼやけていたこ

単結晶X線回研実験における振動与真において、スホットかはやけていたことから、この PbVO3単結晶は twin になっていると考えられる.これは 6GPa の 圧力で結晶成長させた後の減圧過程において、立方晶から正方晶へ構造相転移を起こすためであると推測できる.単結晶を粉末に砕いた試料においてこのような現象が起こった原因は定かではないが、おそらくは PbVO3 結晶試料の微細 なドメイン構造が関係しているものと考えられる.



Fig.3 PbVO₃の放射光X線回折パターンとリートベルト解析. 赤点は測定データ,黒実線は計算結果,緑のティックはピーク位置,青い実線 は残差曲線を示している.



Fig.4 PbVO3の結晶構造(左)とMEM 解析から求めた電子状態密度(右).

- [1] A. A. Belik, et al., Chem. Mater. (2005) 17, 269.
- [2] R.V. Shpanchenko, et al., Chem. Mater. (2004) 16, 3267.
- [3] K. Oka et al., Inorg. Chem., in press.
- [4] Y. Uratani et al., Jpn. J. Appl. Phys. (2005) 44, 7130.